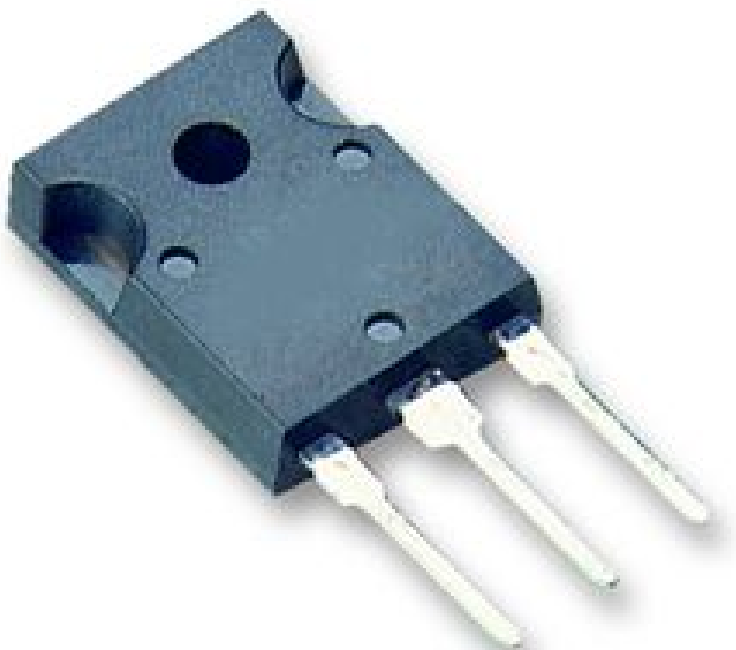


Transistor G12N60C3D IGBT Canal N 600V 12A

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SAV12N60AD



Transistor G12N60C3D IGBT Canal N 600V 12A

?Transistor G12N60C3D IGBT Canal N 600V 12A

Fabricant : ONSEMI

Type de transistor : IGBT

Tensions collecteur-émetteur : 600V

Courant du collecteur : 12A

Puissance de dissipation : 104W

Boîtier : TO247-3

Tension entrée - émetteur : $\pm 20V$

Courant du collecteur d'impulsion : 96A

Montage : THT

Charge d'entrée : 71nC

Packaging :	
Dimensions produit :	

